This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CIRCUIT BOARD MATERIAL AND PROCESS OF MAKING

Also published as: Patent number: WO8607100 EP0224572 (A1) 1986-12-04 **Publication date:** US4808967 (A1) MAHLER BRUCE P (US); RICE JAMES M (US) Inventor: GB2186888 (A) OHMEGA TECHNOLOGIES INC (US) Applicant: EP0224572 (A4) Classification: C25D3/56; H01C7/00 - International: C25D3/56B, H01C7/00E, H01C17/16, H05K1/16R Cited documents: - european: WO1986US01173 19860528 **Application number:** US2643221 US3077442 US19850738835 19850529 Priority number(s): US3743583 US3808576 US3857683 more >>

Abstract not available for WO8607100 Abstract of correspondent: **US4808967** \

A multilayered circuit board material is disclosed. The material includes an insulating material support layer, an electrical resistance material layer adhering to the support layer, and a conductive material layer adhering to the resistance material layer and in intimate contact with that layer. The electrical resistance material layer is formed from electroplated nickel-phosphorous containing up to about 30% by weight of phosphorous; however, no appreciable amounts of sulfur are present within at least the top about ten atomic layers of the electrical resistance material layer. As a result, the stability of the electrical resistance material layer is significantly increased. In addition, the electroplating bath does not contain chloride salts resulting in decreased pitting in the electrical resistance material layer.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公妻

⑫公表特許公報(A)

昭63-500133

(全 6 頁)

			❽公衷	昭和63年(1988)1月14日
***				~ , (, _ , , _ , , _ , ,
绘划配盘	宁 内敦神张县	新世 ·木· 李本 ·十	-de Orderados	

@Int.Cl,4	識別記号	宁内整理番号	審査請求	未請求		
H 05 K 1/16 C 25 D 3/12 H 01 C 7/00		-6736-5F 6686-4K	子備審查請求	未請求	部門(区分)	7 (2)
H 01 C 7/00 H 05 K 3/18		-8525-5E -6736-5F	•		(Δ	c ল)

砂発明の名称 配線基板材料

②特 願 昭61-503230 ⑩②出 願 昭61(1986)5月28日

國翻訳文提出日 昭62(1987)1月28日 國国 際 出 願 PCT/US86/01173 國国際公開番号 WO86/07100

⑩国際公開日 昭61(1986)12月4日

優先権主張 Ø1985年5月29日 砂米国(US) ⑩738835

砂発 明 者 ライス、ジェイムズ、エム アメリカ合衆国、カリフオルニア州90403、サンタ・モニカ、イレ

ヴンス・ストリート1027、ユニツト・イー

⑫発 明 者 マーラー、ブルース、ピー アメリカ合衆国、カリフオルニア州91362、サウザンド・オーク

ス、マクレイ・ロード1936

⑪出 願 人 オメガ、テクノロジイズ、イン アメリカ合衆国、カリフオルニア州90230、カルヴアー・シティ、コーポレーテツド エレンダ・ストリート 4031

コーポレーテッド エレンダ・ストリート4031

砂代 理 人 弁理士 木村 高久

⑩指 定 国 AT, CH, DE, DE, FR(広域特許), GB, IT(広域特許), JP, NL, SE

浄哲(内容に変更なし) 請 求 の 範 囲

1. 支持層と、

該支持履に被着せしめられる少なくとも一つの電気 抵抗材料配と、

該電気抵抗材料層に被牾せしめられる導電材料圏と、 を含みかつ電気抵抗材料圏が電子プレートニッケル ーリン成分を含み、

電気抵抗材料局の少なくとも表面の約,10原子間がイオウを含有しないようにしたことを特徴とする多層 構造型のプリント配線基板材料。

- 2. 前記導電材料層が網箔を含みかつ前記支持層が強化有機制脂を含むことを特徴とする請求の範囲第 (1) 項記載のプリント配線材料。
- 3. 的記導器材料層は扇所的に高い部分をもつ網箔を 含むものであることを特徴とする頭求の範囲第 (1) 項 記載のプリント配線基板材料。
- 4. 約30重量パーセント以下のリンを含む電子プレートニッケルーリンを含み、少なくともその最上層の約10原子層がイオウを含有しないものであることを特徴とする多圏配線基板の電気抵抗材料層の構造。
- 5. 約8ないし第30重量パーセントのリンが存在することを特徴とする額求の範囲第4項記収の電気抵抗材料層。
- 6. (a) 基板の洗浄工程と
 - (b) 実質的にイオウを含まずかつNiCOs.

浄省(内容に変更なし)

H 3 P O 3 および H 3 P O 4 を含む粉中で基板を電子 プレーティングする工程とを含むことを特徴とする基 板への電子プレーティング方法。

- 7. 前記浴は実質的には、塩化物を含有しないものであることを特徴とする請求の範囲第(6) 項記載の方法。 8. 前記浴は実質的には硫化ニッケルを含有しないものであることを特徴とする請求の範囲第(6) 項記載の方法。
- 9. 前記俗は実質的には塩化ニッケルを含有しないものであることを特徴とする請求の範囲第(6) 項記載の方法。
- 11. 絶縁性の支持層と、約30 度 最 % 以下のリンを含む電気プレートリン酸ニッケルからなる電気 抵抗材料層と、 将電材料解とを有する多層配線プリント基板材料において、 前記電気抵抗材料層が400 倍の拡大図において実質的にピンホールもなく連続的であることを特徴とする多層配線プリント基板材料。
- 12. 前記電気抵抗材料層の少なくとも最上層の約 10原子層がイオウを含有しないようにしたことを特徴とする請求の範囲第11項記載の配線基板材料。
- 13. 前記電気抵抗材料層が実質的にイオウを含有しないようにしたことを特徴とする請求の範囲第12項

冷谷(内容に変更なし)

記載の配録基板材料。

14. 前記電気抵抗材料圏の最上層の約10原子圏は2世級%以下のイオウを含有するものであることを特徴とする請求の範囲第11項記載の配線基板材料。
15. プリント配線基板材料の支持基板上にニッケルーリン抵抗圏を電子プレーティングするのに用いられる電子プレート浴において、前記浴が実質的には炭酸ニッケル、リン酸および亜リン酸からなることを特徴とする電子プレート浴。

られたニッケルーリン電気抵抗材料層は、極めてポーラス (多孔性)でかつ剥離強度が低い等のいくつかの問題をかかえている。さらには、電気抵抗材料層の他の電気的特性を高めることが望まれている。

発明の誤要

図面の説明

第1回は済定曲線である、

第2回は従来技術の方法によって形成される電気 抵抗闘の表面の写真である。

第3図は、本発明の方法によって形成される 電気 抵抗層の表面の写真である。 明 部 含 配線基板材料 背身技術

1. 発明の分野

本発明は、配額基板材料の製造方法、特に、電子 プレート法による多層プリント配線基板材料に関する。 2. 健来技術

オメガ、テクノロジイズ、インコーポレーテッド に協設された発明である米国特許明細母第38085 76号には、聯電材料圏と良好に接触する電気抵抗材 科暦の結合せしめられた絶縁支持閥を含む多層プリン ト配線基板が開示されている。この発明に開示されて いる電気抵抗材料圏は電子プレートニッケル圏であり、 この層は約30度量パーセント以下のリンを含んでい る。この中で闘示されている電気抵抗材料圏を形成す る電子プレート浴は、ホウ酸をリン酸および難リン酸 の混合物で置換した領導のワット浴を変形したもので ある。このプレート浴は鼠数ニッケルおよび塩化ニッ ケルをも含有している。硫酸ニッケルは最も便利で最 も低価格のニッケル塩として、塩化ニッケルは陽値侵 食剤として作用することから長年にわたって伝統的な ニッケル塩として、額酸ニッケルおよび塩化ニッケル が使用されてきている。

上述した参照特許の中で開示されたアレート浴を使用することにより、有用な製品が作り出されるが、作

第4図は、プレート沿のリン酸器度に対する本発明の電気抵抗圏のリンの重量パーセントを示す図である。

望ましい実施例の説明

以下に、この発明を実施するのに現在考えられている最も優れた方法について説明する。この説明は、本発明の一般的な原理を説明する目的でなされたものであり、何ら限定的意味に解釈されるべきものではない。本発明の範囲は、従属クレームを参照することにより、最もよく判定される。

本発明は、多層プリント配線基板材料およびその 製造方法を示すものである。一般に、配線基板は、基板、電気気抗材料層、現電材料層の3つの層を具備している。3層のものが代表的であるが、3層以上のものも、本発明の範囲内に含まれる。

本発明の中心は、配線基板材料、特に、電気抵抗材料圏の特性の改良にある。電気抵抗材料圏のプレート浴の側戌部分を変化させることにより、電気抵抗材料圏の安定性および多孔性において重要な改良が関係されることがわかった。

A. 電気抵抗材料圏のプレート浴

本発明の電気抵抗材料圏の改良の鍵はプレート浴内に顕弦塩、さらに望ましくは塩化物塩をも含まないことにある。例えば、リンの含有量が、30%以下であるようなニッケルーリン抵抗材料圏は、本質的には以

B. 製造工程、

例えば割箔等の導電材料基板上にニッケルーリン電気抵抗材料層をプレーティングした後、該電気抵抗材料層に、米国特許明細電郊3808576号で述べたような破化処理がなされる。次いで、この導電ー抵抗材料は、給糠基板に良好に接触するように抵抗材料の破化ニッケル表面上で、この絶禄基板に積度せしめられる。

積層後の鋼表面はフォトレジストを望布された後、 毎体パターンおよび抵抗体パターンを含むネガ写真で

ーであった。 陰極の大きさは 1 1 . 5 インチ× 1 4 . 2 5 インチであり、 閉極は、 プラチナ被配されたニオビウムで、 関係対陸極の比は 1 . 3 : 1 であった。

例1. (基準裕は上述の米国特許明報自第380 8576号および米国特許明細路第2643221号を参照して示されたのと同一材料をもつ)

		g/1	H/L
Ni 504 . 6H 2 0		150	0.57
NiCl2 .6H 2 0		45	0.19
NiCOa		15	0.125
H 3 PO4		49	0.50
H a POa		41	0.50
温	度	7 5	C
76	洗	5 0	アンペア
時		3 0	₽.
Reオーム/		25	

NiCO3 +2H 3 PO3 =Ni(H 2 PO3) 2 +CO 2 +H2 O

C. 電気抵抗材料局のプレート浴の例

		g/1				H/	L
NiCO3.		106				1.	0
H 2 PO3		164			•	2.	0
温	度	7	0	T			
電	77	5	0	7	ン	ベ	7
時	閊	3	0	Đ			
Rs #-	4/0	5					

例3. この例では、0. 25M/Lのリン酸が、 例2の浴に添加される。

		9/1	H/L
NiCO3		106	1.0
H a POa		164	2.0
H 3 PO4	•	2 5	0.25
19	度	7 O T	
, 15	流	50ア	ンペア
時	113	3 O 🕏	
R S 7 - 1	4/0	15	

例4.この例では、リン酸が0.5M/Lまで増 加せしめられている。

9/1 H/1 NICO3 106 1.0 H 3 PO3 164 2.0 H 3 PO4 5.0 0.5 }/2 Œ 7 0 °C * 7 50アンペア 83 23 30#

5 0

R s オーム/ロ

例5. この例では、浴の温度は例1の浴の温度まで増大せしめられている。この浴および例2~例4の浴もまた、完全でないとしても本質的には、ほ化物や塩化物が含まれないと考えるべきである。すなわち、存在する唯一の硫化物や塩化物は、他の成分あるいは水中の不穏物のみである。

		9/1
	Nicoa	106
	H 3 PO3	164
	H 3 PO4	50
. 2	度	7 5 °C
和	流	50アンペア
時	間	30#

空孔(ポイド)やピンホールのあることを説明している。

第2回を本発明の例5による抵抗材料間の表面の400倍の拡大写真である第3回と比較すれば、ピンホールが全くないことがわかる。

事実、 電気抵抗材料 図は 第2 図に示されているピンホールのある表面とは反対に滑らかで、 連続した表面を呈している。 このようにピンホールのないことは、プレート浴中に塩化物イオンのないことによるものと考えられる。 したがって、 本発明は、 塩化物イオンに加えてピンホールを形成するような問題のある材料を含まないプレート浴を考えているものと理解すべきである。

R_S # - L/D 25

D. 意外性

材質およびその結果であるニッケルーリン電気抵抗材料層の物理的および電気的性質の母変な改良点を 説明する意外な現象がいくつか発見された。

まず、例5の浴のPHは例1の浴のPHよりも約1PH 単位程度高い。これはリン酸および亜リン酸のPHと一 致する。例1のPHは亜リン酸ニッケルの配位子の形成 によって、フリーな塩水素酸が形成されているのの おえられる。例えば、例に1/8モルの炭酸ニッケル が1/2モルの亜リン酸と反応したとすると、1/4 モルの未反応の亜リン酸が残る。第1回参照。したが って明らかに塩化ニッケルはフリーな亜リン酸と反応 する。

0.19HiCl2 +0.25H3 PO3 =

0.125Mi(H 2 PO3) 2 +0.065NiCl₂ +0.25HCl 0.25モルのHCIのPHの計算値は

$$\frac{1}{2.5 \times 10^{-10}} = \log \frac{10}{2.5}$$

2.5 の log は 0.395 または 0.4 であり pHは 1.0 - 0.4 = 0.8 である。このことは、基準裕 (例 1) の pHが異常に低いことを説明しており、また基準沿による電気抵抗材料剤の表面の写真 (400 倍の拡大写真) および、第 2 図に示されているように、

由であるかもしれない。このように、本発明では少なくとも電気抵抗材料間の最上度、別えば的 10原子屋では、イオウを含有せず、電気抵抗材料層中に2重量%以下設ましくは全く含まないというのも本発明の認問に入る。

表 1

EDX解析

例 1 の基準浴 例 5 の 浴 Ni 86.1x 87.1x P 13.9 12.9 表 2

XPS解析

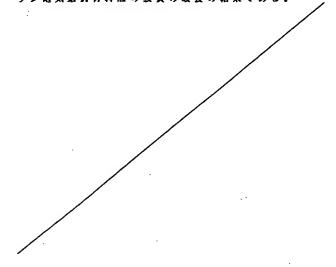
例1の基準浴 例 5 の 浴 S 2.72 0

例5の沿は、0、25×i/0、50PO3から
1、25×i/2、50PO3の範囲で処理されている。電気抵抗材料層のリン含有Qは、プレート浴やのリン酸酸度の関数となっているものと思われる。第5次が中では、例2の浴中では、のの含有Qは無視できる。しかしかの含有Qは無視できる。しかしかがある。プレーティング後の浴中には、0、2M/Lのリン水系化物が存在していることが見いだされた。

このことから、オルソ亞リン酸塩がオルソリン酸 塩と次亜リン酸塩になる初期の不均化が起こり、浴中

表 3.

でいろいろな酸化状態の混合物の平衡をもたらしたものと思われる。



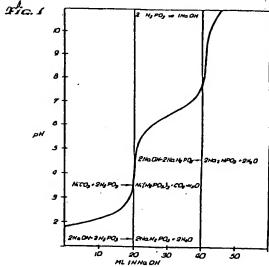
浄杏(内容に変更なし)

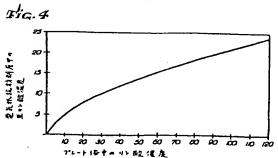
光、4 a m p s) には、本発明のプレート沿によって 多孔性が肉的に改良されていることが鮮明に示されて いる。基準沿で形成された抵抗材料限は比較的よりポ ーラス(多孔的)であり、本発明の抵抗材料限はこの 倍帯では滑らかで進続的である。

一般に、浴は、炭酸ニッケルあるいはそれと等所なもの、リン酸および乗リン酸を、電気抵抗材料層中のリンの量を変化させる、調整可能なリン酸および乗リン酸の風だけ含有せしめるようにしてもよい。

	例 1 の基準浴	例 5 の 浴.
列 赋 強 庭 1bs./inch	6	9
70℃ 15w/ nd 負荷で 1000時間後の抵抗 変化	3 x	0.2x
- 65 でから 125 で における無抗の温 度係数	-50ppm/C	-10ppm/℃
ノイズ電流、マイ クロポルト/ ポル ト	0.5	< 0.02
抵抗値、10″×12 ″のシートにおけ るオーム/ロ	25.0 ± 1.0	25.0± 0.25

そして、前述したように第2図および第3図に示されている類数領写真(400倍、透過光1/2秒段





手続補正樹(坑)

昭和62年10月 7日

特許庁長官 殴

B

1. 部件の表示

国際出願番号PCT/US86/01173

2. 発明の名称

配物基板材料

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

オメガ、テクノロジイズ、インコーポレーテッド

4. 代 理 人 (〒 104) 東京都中央区銀座2丁目11番2号 銀座大作ビル6階 電話 03-545-3508 (代表)

7105 弁理士

木村高久

5. 補正命令の日付

昭和62年9月3日

(発送日 昭和62年9月8日)

6. 補正の対象

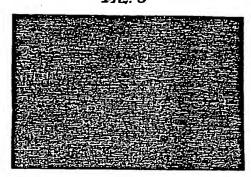
・明細書の翻訳文の浄書(内音に変更なし)及び代理権を 証明する台面

7. 補正の内容

明細律の翻訳文14ページから17ページの浄色(内容に変 更なし)及び代理権を証明する書面を別紙の過り補正する。



Fig. 3



** December 1			international Application by PCT	/US86/01173	
D. C. 204/44.7; 252/513, 518; 338/309 Described planting Considerable Status Described Status Desc	L ELABORIES THE	OF SUBJECT MATTER IN SOURCE TO MY	Acres annuals areas before an I		
D. C. 204/44.7; 252/513, 518; 338/309 Described planting Considerable Status Described Status Desc	DVT. CL. C	250 X367 HDIZ 7/80	Harris Characteristics and IPE		
Constitution by the constitution of the consti	D. B. Ct.	204/44.7; 252/513, 3	110, 334/309		
U.S. 174/68.5, 204/32.1, 44.7; 252/513, 518; 318/108. 103. 1271 478/401 In the Limit Data land December of the Committee of the Finish Seathing 5 In Section of December 19 for RESEARTY Company 1 Chains of December 19 for RESEARTY I State of December 19 for RESEARTY I Spanned of December 19 for RESEARTY Company 1 Chains of December 19 for RESEARTY I Powered of Committee 19 for RESEARTY Company 1 Chains of December 19 for RESEARTY I Spanned december 19 for RESEARTY I Spanned december 19 for RESEARTY Company 1 Chains of December 19 for RESEARCY I Spanned december 19 for RESEARCY I Spanned december 19 for RESEARCY I December 19 for RESEARCY I December 19 for RESEARCY Company 1 Chains I Spanned december 19 for RESEARCY I Spanned december 19 for RESEARCY I December 19 for RESEARCY I Spanned december 19 for RESEARCY I December 19 for RESEAR	IL PHILDS SIARCE				
U.S. 174/68.5, 204/32.1, 44.7; 252/513.518; 318/108.109.1371. 428/901 Bit Commentation Enterined of the Thin Ministra Decommentation to the Commentation and Decomments on Interior of the Think Shandang 1. If. Decomments I the Section of the Commentation of the Think Shandang 1. If. Decomments I the Section of the Commentation of the Commenta	Chromboon System	1			
Blancommittee Survivories of the Ministration of the Ministration Decimination in the Committee Survivories of the Ministration Decimination in the Committee Survivories of the Ministration of the Committee Survivories of the Ministration of the		1			
## December 19 of the decembers of the terrested that the second of performs of the terrest of performs of the terrest of the second of the terrest of the t	v.s.	1 338/108, 104, 127+	428/901	;	
Comment of Department, it with buddenter, where operationally, of the reference passages or Debarte in Claim ID, 15			that industrial December Security is		
Comment of Department, it with buddenter, where operationally, of the reference passages or Debarte in Claim ID, 15					
US, A, 2,643,221 (Brenner et al) 23 June 1953. Figure 9, footnote "a". US, A, 3,077,442 (Roretsky) 12 Pebruary 1963, Column 1, lines 44-48. A US, A, 3,743,581 (Castonguay) 1-15 US, A, 3,808,376 (Castonguay et al) 30 April 1974. US, A, 3,857,663 (Castonguay et al) 31 Decamber 1974. US, A, 3,857,663 (Castonguay et al) 1-15 US, A, 4,4554,219 (Castonguay et al) 1-15 US, A, 4,654,219 (Castonguay et					
23 June 1953, Figure 9, footnote "a". X US, A. 3,077.442 (Eoretsky) 12 Pebruary 1963, Column 1, lines 44-48. A US, A. 3,443,583 (Castonguay) 1-15 US, A. 3,808,576 (Castonguay) 25 April 1974. US, A. 3,807,683 (Castonguay et al) 1-15 US, A. 3,857,683 (Castonguay et al) 1-15 US, A. 3,857,683 (Castonguay et al) 1-15 US, A. 3,857,683 (Castonguay et al) 1-15 US, A. 4,554,219 (Gamblin) 19 Wovember 1978. X.P US, A. 4,554,219 (Gamblin) 19 Wovember 1985, Fxample 2. ** Description of the production of the transmission of the content of the production of the production of the content of the production of the production of the content of the production of the	City City	Hot of Document, 14 with indication, where op	property, of the informat passages of	Retproat to Claim Ro. 10	
12 Pobruary 1963, Column 1, lines 44-46. A US, A, 3,741,583 (Castonguay) 1-15 03 July 1973. US, A, 3,800,576 (Castonguay et al) 1-15 10 April 1974. DS, A, 3,857,683 (Castonguay et al) 1-15 11 December 1974. X.P US, A. 4,554,219 (Castonguay et al) 1-15 12 Wovember 1985, Fxample 2. ** Sement december 1974. ** Transmit of the first determinant the statement of the policy of the policy of the statement of the policy	x Us,	A, 2,643,221 (Brenner 23 June 1953, Pigure	et al) 9, footnote "a".	4-10, 15	
DS. A. J. 608.376 (Castonguay et al.) US. A. J. 608.376 (Castonguay et al.) US. A. J. 557.683 (Castonguay et al.) 1-15 US. A. J. 557.683 (Castonguay et al.) 1-15 US. A. J. 557.683 (Castonguay et al.) 1-15 US. A. 4.556.219 (Gamblin) 19 November 1976. X.P US. A. 4.556.219 (Gamblin) 19 November 1985, Fxample 2. "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the plantage contents of the castonguay et al.) "A decrease state of the castonguay et al.) "A decrease of the castonguay et al.) "A d	x US,	N. 3.077.442 (Roretsk 12 Pebruary 1963, Col	y) umn 1, lines44-48,	4-5	
30 April 1974. US, A. 3,857,683 (Castonguay et al) 31 December 1974. X.P US, A. 4,554,219 (Gamblin) 19 Movember 1985, Fxample 2. ** Special divisions of the Section of Section 1985, Fxample 2. ** Special divisions of the Section of Section 1985, Fxample 2. ** State described in the Section of Section 1985, Fxample 2. ** State described in the Section of Section 1985, Fxample 2. ** State described in the Section of Section 1985, Fxample 2. ** Section of Section 1985, Fxample	A US,	4, 3,743,583 (Castong 03 July 1973.	uay)	1-15	
11. December 1974. X.P US, A. 4,554,219 (Gamblin) 19 Wovember 1985, Frample 2. *Present serveries of state decembers: 1* *A decrement pricing the permit state of the Art state is not decrement to be a particular stronger to a particular strong	us.	A, 3,808,576 (Castong 30 April 1974.	uiy et al)	1-15	
* Present correspond of state decuments; 11 ** Present correspond of state decuments; 11 ** Secure of sufficient to the substance on or other the transmission of the substance of the substanc	A OS.	A. 3,857,683 (Castong 31 December 1974.	uay et al)	1-15	
** Observant afforce par powers stein of the not stein to not ** earlier forcement but includes an open of the translational ** earlier forcement but includes an open of the translational ** observant afforcement of the control of the translational ** observant afforcement of the powers of the powers of the control	x.P US,			4-10. 15	
** deturnment afforces plus promote better of the soft seeks to not ** offer deturnment afforces plus promote better of the soft seeks to not ** offer deturnment but desidented on the color of the transmissional ** offerences which is the force and whole any promote plus plus plus plus plus plus plus plus	4				
"A" deturnment d'afforce par pouvoit éten et les est exert e noi "et effect forcement but inchésses on out d'entre des montes de la comment d'est en les exercises de la comment de la c					
1. described in the formed model on primiting (sprinter) by which is find the transmission of schools be considered and several model. 1. described in the transmission of several model of several control of several contro	"A" destrument defining the particular of this act about to past Commission to be of perfectual followings On principle and make an expectation but Commission and make a commission or theory understand the Commission On the commission of the co				
The decimand including for 1 per second displacement, see, existing an extended of the process o	"E" desputement which many through description on grounder claimful for completely about all control for completely about the consultance for				
** Once-year and the serving state customes *** Once-year monder of the serve admit (ankly *** Once-year monder of the serve admit (ankly *** Once of Mandre Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the Admit Completion of the International Search ** Date of the International S	Security intering to an end disclosure, you, collection or some stages of the security of the				
Bate of the Actual Companion of the International Secret 1 Date of Mading of this International Secret Report 1			"A" decument monder of the same of		
International Separating Authority 5		g Avenues t	Within a mount one		
ISA/OS William Leader	138/03		William Leader		